PASJ2017 WEP042

9 セル超伝導空洞(IHEP-04)の空洞性能試験

CAVITY PERFORMANCE OF IHEP-04 9-CELL CAVITY AT KEK

柳町太亮^{#, A)}, 浅野峰行^{A)}, 今田信一^{A)}, 山田浩気^{A)}, 梅森健成^{B)}, 宍戸寿郎^{B)}, 加古永治^{B)}, Jiyuan Zhai^{C)} Taisuke Yanagimachi^{#, A)}, Mineyuki Asano^{A)}, Shin-ichi Imada^{A)}, Hiroki Yamada^{A)}, Kensei Umemori^{B)}, Toshio Shishido^{B)}, Eiji Kako^{B)}, Jiyuan Zhai^{C)} ^{A)} Nippon Advanced Technology ^{B)} KEK, High Energy Accelerator Research Organization ^{C)} IHEP, Institute of High Energy Physics, Beijing

Abstract

A TESLA type 9-cell superconducting RF cavity (IHEP-04) was produced by IHEP. The vertical test was carried out after a series of the process like inspection of inner surface, electric field distribution measurement, anneal and electropolishing at KEK. The IHEP-04 achieved $E_{acc, max}$ of 23.9 MV/m with Q₀ value of 7.4 × 10⁹. The vertical test results of IHEP-04 are reported in this paper.

1. はじめに

Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences (IHEP) にて製造された TESLA 型 9 セル超伝 導空洞(IHEP-04) について、KEK-STF で内面検査、電 界分布測定、アニール、電解研磨などの一連の表面処 理工程を行ったのちに、たて測定を行った。本レポート では、主に IHEP-04 空洞のたて測定結果について報告 する。

2. たて測定の工程

たて測定を行うにあたり、KEK-STF で受け入れを 実施、以下の工程[1]でたて測定[2]を行った。

①空洞受け入れ検査(厚み測定・内面検査) ②Pre-EP, EP-1 (EP=電解研磨) ③一次洗浄、温水超音波洗浄(50,15min.) ④超純水内面高圧洗浄 (HPR) ⑤アニール処理 ⑥アニール後の内面検査 (⑦内面局所研磨(欠陥等が無ければ省略) ⑧プリチューニング(空洞の共振周波数調整) (9)EP-2 ⑩一次洗浄、温水超音波洗浄(50,15min.) ① 超純水内面高圧洗浄(終了後は封止) 12クリーンルーム (class10 で測定用パーツ取付) (B)class1000 へ移動し、排気系へ接続 (4)He リークチェック、ベーキング 低たて測定スタンドへ移動・空洞吊り下げ 16センサー類取付後、クライオ内へ移動 ⑪液体 He による冷却、たて測定(4K) 18液体 He の減圧後、たて測定(1.6~2K) (19)クライオ内の昇温後、移動・取外し

nat-yama@post.kek.jp

内面検査で空洞内部表面を観察したところ、赤道 部およびアイリスで性能劣化の起因になる欠陥が多 く見つかった。そこで、局所研磨機を用いて局所研 磨を行った。日程の関係上、すべての欠陥を除去す るまでには至らなかった[1]。②、⑤、⑨、⑭におけ る処理条件を Table 1 に示す。

Table 1: Preparation Procedures for Vertical Tests: Anneal, Electric-polishing (EP) and Baking Conditions for IHEP-04 Cavity

Pre-EP	5µm
EP-1st	100µm
Anneal	750°C (~3hour)
EP-2nd	20µm
Baking	120°C (~44hour)

たて測定は、Signal generator より出力した高周波 電力を最大出力 400W のドライバ・アンプを用いて 空洞へ入射する。入射電力 (P_{in}) 、透過電力 (P_t) 、 反射電力 (P_{ref}) 、プローブ電力 (P_{probe}) を測定し、 式(1)から(3)を用いて加速電界 (E_{acc} .) および無負荷 Q 値 (Q_0) を算出し、空洞性能の評価をする。 P_0 : 空洞表面のエネルギー損失、Z:空洞形状から決ま る定数である。

$$Eacc. = Z\sqrt{P_t Q_t} \tag{1}$$

$$Q_0 = P_t Q_t / P_0 \tag{2}$$

$$P_0 = P_{in} - P_t - P_{ref} - P_{probe} \tag{3}$$

3. たて測定結果

3.1 IHEP-04 たて測定結果

IHEP-04 における共振周波数 1303MHz (π -mode) のたて測定結果を Table 2 と Figure 1 および Figure 2 に示す。低い加速電界から記録し、最大値まで測定 をする (π initial)。時間をおいて同様に再度測定し た(π final)。

Table 2: Vertical Te	st Results of IHEP-04	Cavity
----------------------	-----------------------	--------

	π initial	π final
Eacc [MV/m]	23.9	23.8
Q ₀ @ Eacc max	$\sim 7.35 \times 10^{9}$	$\sim \! 8.03 \times 10^{9}$
X-ray @ Eacc max [µSv/h]	0.4	0.5
X-ray on set [MV/m]	18	-
Limit	Quench	Quench

最大加速電界は Table 2 の initial の時で、23.9MV/m ($Q_0 = \sim 7.4 \times 10^9$) であった。空洞性能の限界の原因 は、空洞に取り付けたセンサーの反応から 2 セルの 赤道 130~150 度付近で発熱が起こり、クエンチした ためである。

放射線モニターのセンサーは、クライオモジュールの 中心軸上でクライオモジュール外部に設置している。セ ンサー位置の概略図を Figure 3 に示す。X 線の検出は initial で 18MV/m から起こり、徐々に増加して 10μSv/h まで計測したが、22MV/m 前後で改善された。final では、 initial のように増加は見られず、最大加速電界付近で 0.5μSv/m であった。



Figure 1: Q_0 -Eacc plots in vertical tests of the IHEP-04 cavity.



Figure 2: Heating locations of IHEP-04 cavity (π -mode) measured by T-mapping system.



Figure 3: X-ray sensor position.

3.2 IHEP-04とKEK で測定された空洞の比較

IHEP-04 のたて測定結果を、過去に KEK で測定した IHEPの空洞(IHEP-03)[3]および KEK の空洞(MHI-27) [4]と比較する。各たて測定の Q₀-Eacc 曲線を Figure 4、 Figure 5 に、各空洞における最大加速電界などの結果を まとめたもの Table 3 に示す。IHEP-03 と MHI-27 の空洞 形状は TESLA-Like 型である。

 Q_0 -Eacc 曲線の傾向は加速電界が高くなるにつれて Q_0 が徐々に上がり、3-4MV/m 付近で Q_0 が最大になる。 それ以降は加速電界が高くなるにつれ Q_0 は直線的に減 少し、発熱によりクエンチする同様の曲線になる。

IHEP-04 の最大加速電界は MHI-27 よりは低いが、 IHEP-03 より高い。しかし、Table 3 の表面抵抗(Rs)の値 をみてみると IHEP-04 が他の2つの空洞より高い値に なっている。温度が 2K のときの加速電界(3.5 ± 0.1 MV/m)で各空洞の Q₀を比較してみると、IHEP-04 は

PASJ2017 WEP042

 $Q_0 = 1.17 \times 10^{10}$ 、IHEP-03 は $Q_0 = 1.42 \times 10^{10}$ 、MHI-27 は $Q_0 = 1.44 \times 10^{10}$ という結果である。IHEP-04 の加速電 界は IHEP-03 より高い値を得られるたが、 Q_0 は他の空洞 より性能が低いということがわかった。

放射線の値をみてみると、3 台とも initial では放射線 量が多いが、徐々に改善されていき、IHEP-04 と IHEP-03 はモニターで検出できない値に、MHI-27 は 50μSv/h 程度に減少した。

Table 3: Vertical Test Results

	IHEP-04	IHEP-03	MHI-27
Eace [MV/m]	23.8	16.6	25.8
Q_0 @ Eacc max	$\sim \! 8.03 \times 10^{9}$	$\sim 1.33 \times 10^{10}$	$\sim 6 \times 10^{9}$
X-ray @ Eacc max [µSv/h]	0.5	0	48
Limit	Quench	Quench	Quench
Rs $[n\Omega]$ @2K	25.2	19.8	20.5





Figure 4: Q₀-Eacc plots in vertical tests of the IHEP-03.

Figure 5: Q₀-Eacc plots in vertical tests of the MHI-27.

4. まとめ

IHEP にて製造された TESLA 型 9 セル超伝導空洞 (IHEP-04) について、たて測定を行った。達成さ れた最大加速電界として、23.9MV/m (Q₀=7.4×10⁹) の結果が得られた。空洞セル部分に取り付けたセン サーより2セル赤道に発熱がみられたため、それが 原因となりクエンチしてフィールドリミットとなっ ていると考えられる。

IHEP-04 は Q_0 が低かったものの、 Q_0 -Eacc 曲線は これまでに製造された IHEP の空洞や KEK の空洞と 類似する傾向の Q_0 -Eacc 曲線を得られた。

今後再測定を行う場合は、内面検査を実施し発熱 箇所の詳細とその部分で発熱原因になりそうな欠陥 がないかを調査し、局所研磨による処理などをほど こして、たて測定を行う必要があると思われる。

参考文献

- M.Asano *et al.*, "Inspection of inner surface in IHEP-04 9cell cavity at KEK" Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Aug. 1-3, (2017), WEP043.
- [2] T.Shishido, "超伝導空洞の性能評価", OHO'14 program no.6 in KEK.
- [3] M.Asano *et al.*, "Cavity performance tests of IHEP-03 9-cell cavity" Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Chiba, Aug. 8-10, (2016), TUP021.
- [4] T.Yanagimachi *et al.*, "Vertical test results of 9-cell SC cavitys for STF2-CM2B", Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Aug. 5-7, (2015), THP051.
- [5] E.Kako, "超伝導空洞の基礎", OHO'14 program no.5 in KEK.